

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)

# 2SA1387

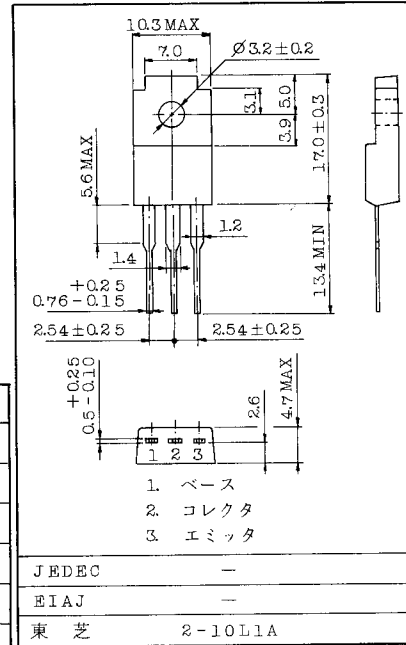
0 大電流スイッチング用

通信工業用

単位: mm

特長

- 直流電流増幅率が高い。:  $h_{FE} = 150$  (最小) ( $I_C = -1A$ )
- コレクタ飽和電圧が低い。:  $V_{CE(sat)} = -0.4V$  (最大) ( $I_C = -3A$ )
- スwitching時間が速い。:  $t_{stg} = 1\mu s$  (標準)
- 絶縁ブッシング, マイカ等が不要な TO-220 相当のアイソレーションパッケージです。



最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位	
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-60	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-50	V	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-7	V	
コレクタ電流	$I_C$	-5	A	
ベース電流	$I_B$	-1	A	
コレクタ損失	$P_C$	$T_a = 25^\circ C$	2.0	W
		$T_c = 25^\circ C$	2.5	
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$	
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$	

電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -50V, I_E = 0$	-	-	-1	$\mu A$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -7V, I_C = 0$	-	-	-1	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-50	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -1A$	150	-	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -3A$	70	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.075A$	-	-0.15	-0.4	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.075A$	-	-0.8	-1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -4V, I_C = -1A$	-	80	-	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	-	200	-	pF
スイッチング時	ターンオン時間	$t_{on}$	-	0.2	-	$\mu s$
	蓄積時間	$t_{stg}$	-	1	-	
	下降時間	$t_f$	-	0.2	-	